

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия K157 состоит из микросхем, выполненных по полупроводниковой технологии.

Эти микросхемы предназначены для работы в АМ-трактах радиоприемных и других устройств.

КОНСТРУКЦИЯ

Микросхемы серии K157 конструктивно оформлены в прямоугольном пластмассовом корпусе типа 20I.14 с 14-и штырьковыми выводами.

Габаритный чертеж корпуса представлен на рис. 8 приложения. Условия эксплуатации даны в таблице, графа 9.

Таблица I

КЛАССИФИКАЦИЯ

Обозначение микросхемы	Электр. схема Рис.	Выполняемая функция
K157УС1	1	Усилитель низкой частоты
K157УС2	2	Усилитель высокой частоты с преобразователем
K157УС3	3	Усилитель промежуточной частоты с АРУ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	KI57YCI	KI57YC2	KI57YC3
I	2	3	4
Напряжение источника питания, В	$9^{+1}_{-3},4$	$5^{+1}_{-1},4$	$5^{+1}_{-1},4$
Мощность, потребляемая от источника питания, мВт, не более	50	25	25
Номинальное выходное напряжение (соответствует выходной мощности 0,5 Вт на нагрузке 6,5 Ом), В	1,8	-	-
Чувствительность (при $U_{вх} = 1,8$ В), мВ	15 - 30	-	-
Ток покоя, мА, не более	5,0	-	-
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более при $U_{вх} = 1,8$ В, %, не более	-	-	3
Диапазон частот (при неравномерности 6 дБ), Гц	0,3	-	-
Потребляемый ток, мА, не более	60-10000	-	-
Напряжение гетеродина (на эквивалентном сопротивлении контура гетеродина, равном 4 Ом, между выводами 5, 8 на частоте 15 МГц), мВ	-	3	4
	-	300-450	-

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
<p>Кoeffициент усиления в режиме преобразования (при нагрузке мостика на эквивалентное сопротивление 10 КОМ между выходами I0 и I2 и при частоте сигнала 150 кГц) .</p>	-	150 - 350	-
<p>Уменьшение усиления в режиме преобразования на частоте 15 МГц по отношению к усилению на частоте 150 кГц, дБ, не более</p>	-	5	-
<p>Кoeffициент шума в режиме преобразования (при включенном фильтре ЛФЧФ) на нагрузке 150 кГц, дБ, не более</p>	-	6	-
<p>Входное сопротивление на частоте 465 кГц, Ом</p>	-	-	430-1000
<p>Работа АРУ (на частоте 465 кГц):</p>	-	-	50-3000
<p>- изменение входного сигнала, мкВ</p>	-	-	6
<p>- изменение выходного сигнала, дБ, не более</p>	-	-	-
<p>Максимальное напряжение на выходе АРУ (выход I3 микросхемы под нагрузкой 3,9 КОМ), В</p>	-	-	3,0 - 4,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

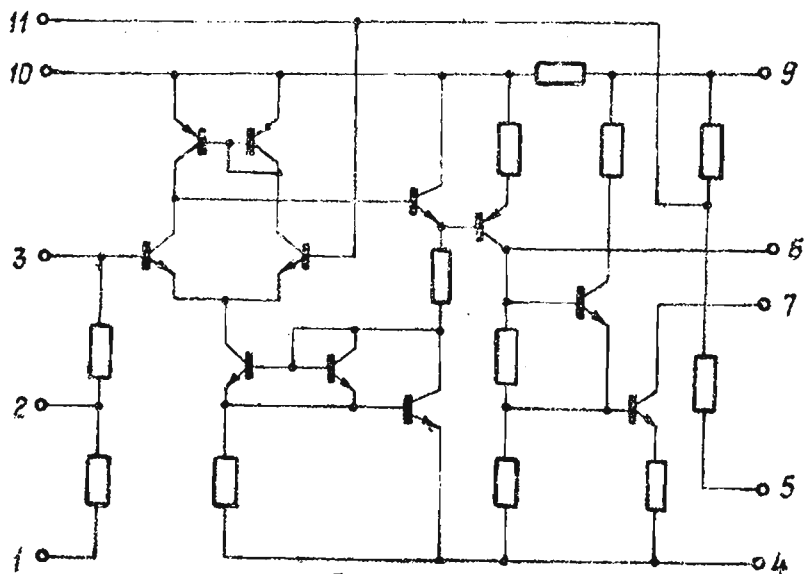


Рис.1
К157УС1

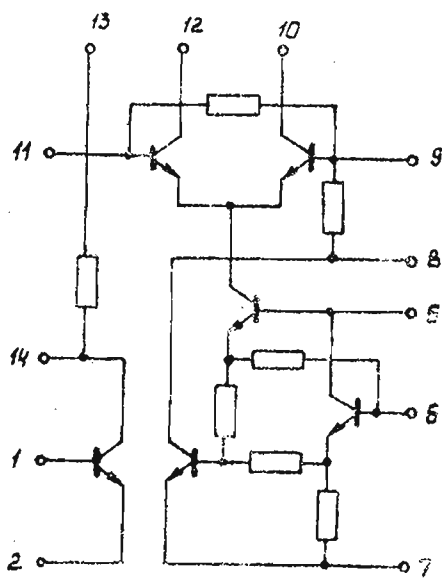


Рис.2
К157УС2

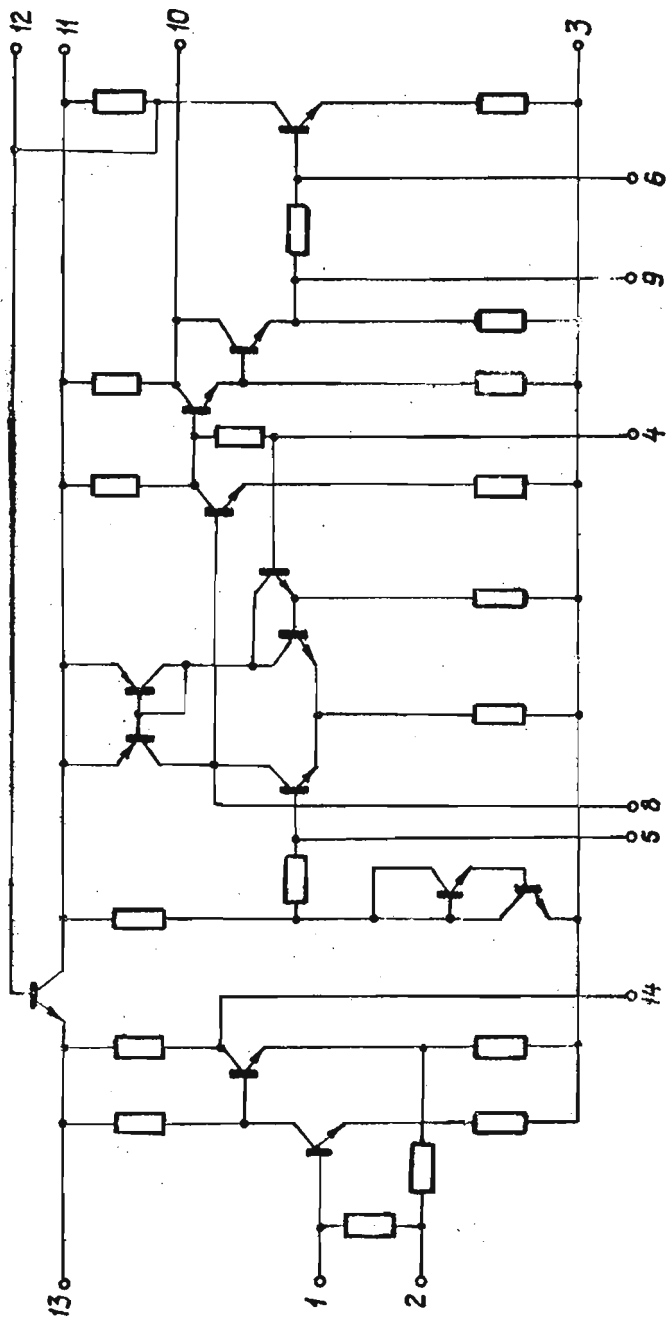


Fig. 3
KI57UC3